RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP9146276
Publication date: 1997-06-06

Publication date: 1997-06-06
Inventor: SHIMADA

SHIMADA ATSUFUMI; SHIMOKAWA TSUTOMU; ENDO

MASAYUKI

Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- International: G03F7/004; G02B5/20; G03F7/022; G03F7/027; G03F7/029;

G03F7/032; G03F7/033; G03F7/039; H01L21/027; G03F7/004; G02B5/20; G03F7/022; G03F7/027; G03F7/029; G03F7/032; G03F7/033; G03F7/039; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/039; G02B5/20; G03F7/024; G03F7/022; G03F7/027; G03F7/029;

G03F7/033; H01L21/027

- european:

Application number: JP19950304023 19951122 Priority number(s): JP19950304023 19951122

Report a data error here

Abstract of JP9146276

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve heat resistance, adhesion, transparency, chemical resistance, etc., by incorporating a copolymer contg. unsatd. carboxylic acid and a specified epoxy group-contg. radical-polymerizable compd. as copolymerized components, a 1,2-quinonediazido compd. and a potential acid generating agent. SOLUTION: This compsn. contains a copolymer contg. unsatd, carboxylic acid and an epoxy group-contg. radical polymerizable compd. represented by the formula as copolymerized components, a 1,2-quinonediazido compd. and a potential acid generating agent. The copolymer may further contain other radical-polymerizable compd. copolymerizable with the unsatd. carboxylic acid and the epoxy group-contg. radical-polymerizable compd. as a copolymerized component. In the formula, each of R1 -R3 is H or 1-10C alkyl and (m) is an integer of 1-5.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-146276

(43)公開日 平成9年(1997)6月6日

| (51) IntCL ⁶ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | ΓI | | | | | 技術表示箇所 |
|-------------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----|--------|-----|------------|----------|
| GOSF | 7/039 | 501 | | C 0 | 3 F | 7/039 | | 501 | |
| G02B | 5/20 | 101 | | C 0 2 | 2 B | 5/20 | | 1.01 | |
| G03F | 7/004 | 503 | | G 0 3 | 3 F | 7/004 | | ь 03 | |
| | 7/022 | 501 | | | | 7/022 | | 501 | |
| | 7/027 | 511 | | | | 7/027 | | 511 | |
| | | | 審查請求 | 未請求 | 水植 | 項の数 2 | OL | (全 13 頁) | 最終頁に続く |
| (21) 出願番号 | | 特顧平7-304023 | | (71) | 人類出 | 000004 | 178 | | |
| | | 110171 | | ` ' ' | | - | 成ゴム | 株式会社 | |
| (22) 出顧日 | | 平成7年(1995)11/ | 122日 | | | | | 築地2丁目11: | 番24号 |
| | | | | (72) | 発明者 | 磐田 | 篇文 | | |
| | | | | | | 東京都 | 中央区 | 築地二丁目11 | 番24号 日本合 |
| | | | | | | 成ゴム | 株式会 | 社内 | |
| | | | | (72) | 発明者 | 一下川 | 努 | | |
| | | | | | | 東京都 | 中央区 | 英地二丁目11 | 番24号 日本合 |
| | | | | | | 成ゴム | 株式会 | 社内 | |
| | | | | (72) | 発明者 | 遠摩 | 出之 | | |
| | • | | | | | 東京都 | 中央区 | 築地二丁目11 | 番24号 日本合 |
| | | | | | | 成ゴム | 株式会 | 此内 | |
| | | | | 1 | | 弁理士 | | | |

(54) 【発明の名称】 威放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 感度、現像性、残膜率、耐熱性、基板との密 着性、透明性および耐薬品性に優れたポジレジスト性感 放射線性組成物を提供する。

【解決手段】 (A) 不飽和カルボン酸、グリシジルオキシメチル基置換スチレン系モノマーおよびその他のモノマーからなる共重合体、(B) 1,2-キノンジアジド化合物並びに(C)潜在性酸発生剤を含有する感放射線性組成物が提供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 [A] (a-1)不飽和カルボン酸および(a-2)下記一般式[I]

【化1】

(上記一般式 [I] 中、 $R^1 \sim R^3$ は各々独立に、水素原子または炭素数 $1 \sim 1$ 0のアルキル基であり、m は $1 \sim 5$ の整数である。) で示されるエポキシ基含有ラジカル 重合性化合物、とを共重合成分として含有する共重合体、[B] 1, 2-キノンジアジド化合物、並びに

[C]潜在性酸発生剤、を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【請求項2】 上記共重合体の共重合成分として、(a-3)上記不飽和カルボン酸と上記エボキシ基含有ラジカル重合性化合物と共重合しうる他のラジカル重合性化合物を含有する請求項1記載の感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、半導体集積回路、液晶ディスプレイ(以下、「LCD」という)用薄膜トランジスタ(以下、「TFT」という)回路などの回路製造用のマスクを作成するためのポジ型レジストとして好適な、さらには層間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜などの永久膜形成材料としても好適な感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路(以下、「IC」という)の製造においては、高解像度を有するとともに高感度を有するレジストとして用いられる感放射線性樹脂組成物が求められている。

【0003】即ち、ICの製造の際には、サブミクロン以下の高解像度が得られるレジストが要求されることもあるが、一般的には数μm~数十μmオーダーの解像度が得られ、且つ特に大口径化されたシリコンウェハを用いてスループットを上げても高い歩留まりを示す高感度レジストが強く要望されている。

【0004】また、例えばICの製造の際のシリコンウェハのエッチング工程では、大量にバッチ処理が可能なウェットエッチング方式で行われることが多く、このため形成されるレジストパターンには、基板との密着性やエッチング液に侵されない耐薬品性が必要とされる。またイオンインプラ工程などが加わる場合には、高温加熱に耐えうる耐熱性が要求される。

【0005】そして、従来、ノボラック樹脂と1,2-キノンジアジド化合物とを含むポジ型レジストが知られ ており、ICの製造の際に多く用いられている。しかしながら、このボジ型レジストは、解像度には優れているが、上記のようなウェットエッチングに耐えうる耐薬品性、さらには感度、基板との密着性、耐熱性などについては充分な特性を有しているとはいえない。

【0006】また近年、急速に発展してきたLCDにおいて、LCDの中でもとりわけ1 画素ごとにTFTを組み込んだアクティブマトリクス型LCD(以下、「AM-LCD」という)は、その応答速度の早さからブラウン管に代わる次世代表示デバイスの本命とみなされており、表示画面の大面積化が望まれている。このようなAM-LCDのTFT回路の形成にも、ICの場合と同様にレジストが用いられている。

【0007】さらにLCDを製造する際には、従来熱硬化性樹脂組成物を用いて形成されている層間絶縁膜、カラーフィルター用保護膜などの永久膜を、レジストと同様の組成物で形成しようとする試みが行われている。

【0008】このようなLCDの永久膜には、耐熱性、耐薬品性、透明性などが要求されるが、上記のようなノボラック樹脂とキノンジアジド化合物とを含む従来のボシ型レジストでは、耐薬品性、基板との密着性、耐熱性などの点で充分満足のいく永久膜を形成できるものではなかった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、新しい感放射線性樹脂組成物を提供することである。本発明の他の目的は、IC、LCD用TFT回路などの回路製造用であって、感度、現像性、残腹率、耐熱性および基板との密着性に優れた、アルカリ水溶液からなる現像液によって現像しうるポジ型レジストとして好適な感放射線性樹脂組成物を提供することである。

【0010】本発明のさらなる他の目的は、LCDの層間絶縁膜およびカラーフィルター保護膜で例示される永久膜を形成するためのものであって、耐熱性、基板との密着性、可視光領域における透明性、耐薬品性などに優れた永久膜を与え得る感放射線性樹脂組成物を提供することである。

[0011]

【発明を解決するための手段】本発明の上記目的および 利点は、

[A] (a-1) 不飽和カルボン酸および (a-2) 下 記一般式 [I]

[0012]

【化2】

【0013】(上記一般式[I]中、R1~R3は各々独

立に、水素原子または炭素数1~10のアルキル基であり、mは1~5の整数である。)で示されるエポキシ基合有ラジカル重合性化合物、とを共重合成分として含有する共重合体(以下、「共重合体[A]」ともいう)、[B]1.2-キノンジアジド化合物、並びに

[C] 潜在性酸発生剤、を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。以下、本発明を詳述するが、それにより本発明の別の目的、利点および効果が明らかとなろう。

【0014】以下、まず本発明に係る感放射線性樹脂組成物に含まれる各成分について説明する。なお、本発明で「放射線」という語は、紫外線、選紫外線、X線、電子線、分子線、ケ線、シンクロトロン放射線、プロトンビーム線などを含む概念で用いられる。

【0015】共重合体[A]

本発明で用いられる共重合体 [A]は、不飽和カルボン酸(a-1)および上記一般式 [I]で示されるエボキシ基含有ラジカル重合性化合物(a-2)を共重合成分として含有し、必要に応じて上記不飽和カルボン酸(a-1)およびエボキシ基含有ラジカル重合性化合物(a-2)と共重合しうる他のラジカル重合性化合物(以下、「他のラジカル重合性化合物」ともいう。)(a-3)を共重合成分として含有する共重合体である。

【0016】本発明で用いられる上記不飽和カルボン酸(a-1)としては、エチレン性不飽和二重結合を有する不飽和カルボン酸が挙げられる。

【0017】このような不飽和カルボン酸(a-1)の 具体例としては、メタクリル酸、アクリル酸、クロトン 酸、o-ビニル安息香酸、m-ビニル安息香酸、p-ビ ニル安息香酸などのモノカルボン酸;マレイン酸、フマ ル酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸、1.4 ーシクロヘキセンジカルボン酸、3ービニルフタル酸、 4ービニルフタル酸、メチルー5ーノルボルネンー2, 3ージカルボン酸、3,4,5,6ーテトラヒドロフタル 酸、1,2,3,6ーテトラヒドロフタル酸、ジメチルテトラヒドロフタル酸などのジカルボン酸が挙げられる。 これらのうち、メタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸などが好ましく用いられる。

【0018】また、本発明では、不飽和カルボン酸(a -1)として、カルボキシル酸基の一部が未反応のまま 残存している、上記不飽和カルボン酸の部分エステル化 物または部分アミド化物、例えば不飽和ジカルボン酸のハーフエステルまたはハーフアミドを用いることもできる。このような不飽和カルボン酸のハーフエステルまたはハーフアミドとしては、イタコン酸モノメチル、イタコン酸モノブチルなどが好ましく用いられる。これらの 化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0019】上記一般式 [I]で示されるエポキシ基含有ラジカル重合性化合物 (a-2)の具体例としては、

oービニルベンジルグリシジルエーテル、mービニルベンジルグリシジルエーテル、pービニルベンジルグリシジルエーテル、αーメチルーoービニルベンジルグリシジルエーテル、αーメチルーmービニルベンジルグリシジルエーテル、αーメチルーpービニルベンジルグリシジルエーテル、2,3ージグリシジルオキシメチルスチレン、2,4ージグリシジルオキシメチルスチレン、2,6ージグリシジルオキシメチルスチレン、2,3,4ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,3,5ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,3,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,3,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレン、2,4,6ートリグリシジルオキシメチルスチレンなどが挙げられる。

【0020】これらのうち、oービニルベンジルグリシジルエーテル、mービニルベンジルグリシジルエーテル、pービニルベンジルグリシジルエーテルなどが好ましく用いられる。これらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0021】本発明で用いられる他のラジカル重合性化 合物 (a-3) の具体例としては、(メタ) アクリル酸 **グリシジル、αーエチル (メタ) アクリル酸グリシジ** ル、α-n-プロピル (メタ) アクリル酸グリシジル、 $\alpha - n -$ ブチル (メタ) アクリル酸グリシジル、3,4 ーエポキシブチル (メタ) アクリレート、3,4ーエポ キシヘプチル (メタ) アクリレート、α-エチル-6, **7ーエポキシヘプチル (メタ) アクリレート、アリルグ** リシジルエーテル、ビニルグリシジルエーテルなどの上 記一般式[I]で示されないエボキシ基含有ラジカル重 合性化合物:スチレン、α-メチルスチレン、o-メチ ルスチレン、mーメチルスチレン、pーメチルスチレ ン、pーメトキシスチレン、pーメトキシメチルスチレ ン、p-tert-ブトキシスチレン、クロロメチルス チレンなどのスチレン類; ブタジエン、2,3-ジメチ ルブタジエン、イソプレンなどのジエン類;(メタ)ア クリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸-n-プロピル、(メタ)アクリル酸-i-プロピル、(メタ)アクリル酸-n-ブチル、(メタ) アクリル酸-sec-ブチル、(メタ)アクリル酸-t erーブチル、(メタ)アクリル酸-2-エチルヘキシ ル、(メタ)アクリル酸ラウリル、(メタ)アクリル酸 ドデシル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンタニル、 (メタ) アクリル酸イソボロニル、(メタ) アクリル酸

(メタ) アクリル酸イソボロニル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) アクリル酸2-メチルシクロヘキシル、(メタ) アクリル酸ジシクロヘキシル、(メタ) アクリル酸アダマンチル、(メタ) アクリル酸アリル、(メタ) アクリル酸プロバギル、(メタ) アクリル酸フェニル、(メタ) アクリル酸ナフチル、(メタ) アクリル酸アントラセニル、(メタ) アクリル酸ンクロペンチル、(メタ) アクリル酸フリル、(メタ) アクリル

酸テトラヒドロフリル、(メタ)アクリル酸ピラニル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸フェネシル、(メタ)アクリル酸フレシル、(メタ)アクリル酸ー1,1,1ートリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオローカープロピル、(メタ)アクリル酸トリフェニルメチル、(メタ)アクリル酸クミルなどの(メタ)アクリル酸にステル;

【0022】(メタ)アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸-2-ヒドロキシプロピルなどの(メタ)アクリル酸ヒドロキシアルキルエステル;(メタ)アクリル酸ーアミド、-N,N-ジメチルアミド、-N,N-プロピルアミドなどの(メタ)アクリル酸アミド;(メタ)アクリル酸ーアニリド、(メタ)アクリロニトリル、アクロレイン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、N-ビニルピロリドン、酢酸ビニルなどのビニル化合物;マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタコン酸ジエチルなどの不飽和ジカルボン酸ジエステルなどが挙げられる。

【0023】これらのうち、(メタ)アクリル酸グリシジル、スチレン、αーメチルスチレン、pーtertブトキシスチレン、メタクリル酸ジシクロペンタニル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ー2ーヒドロキシエチル、メタクリル酸ベンジル、ブタジエンなどが好ましく用いられ、メタクリル酸グリシジルおよびスチレンが特に好ましく用いられる。メタクリル酸グリシジルを共重合成分として用いることにより、共重合体 [A]の放射線照射後の架橋密度を高めることができ、その結果、耐薬品性がより向上する。また、スチレンを共重合成分として用いることにより、ポリマーのアルカリ溶解性を任意にコントロールすることができ、その結果、解像度および残膜率が向上する。これらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0024】本発明で用いられる共重合体 [A]は、上記の各化合物を共重合させることにより得られ、不飽和カルボン酸 (a-1)を、通常5~50重量%、好ましくは10~40重量%の量で、エポキシ基含有ラジカル重合性化合物 (a-2)を、通常5~90重量%、好ましくは20~50重量%の量で、他のラジカル重合性化合物 (a-3)を、通常70重量%以下、好ましくは20~60重量%の量で含有している。

【0025】不飽和カルボン酸(a-1)の含量が5重量%未満であると、得られる被膜はアルカリ水溶液からなる現像液に対する溶解性が低下して現像性が悪化したり、感度が低下する場合がある。一方50重量%を超えると、得られる被膜はアルカリ水溶液に対する溶解性が大きくなりすぎ、得られるレジストパターンの残膜率が悪化する場合がある。また、エボキシ基含有ラジカル重合性化合物(a-2)の含量が5重量%未満であると、

得られる被膜は架橋密度が不足して耐熱性や耐薬品性が 劣ることがあり、一方90重量%を超えると、得られる 被膜はアルカリ水溶液に対する溶解性が低下して現像性 が悪化したり、感度が低下する場合がある。さらに、他 のラジカル重合性化合物(a-3)の含量が70重量% を超える場合には、ポリマーのアルカリ水溶液からなる 現像液に対する溶解性のバランスが悪くなり、パターニ ングが困難になる場合がある。

【0026】本発明で用いられる共重合体 [A] は、ポリスチレン換算重量平均分子量 (以下、「Mw」という)が、通常、 $2\times10^3\sim1\times10^5$ 、好ましくは $5\times10^3\sim5\times10^4$ であることが望ましい。 $Mwが2\times10^3$ 未満であると、得られる被膜は、現像性、残膜率などが低下したり、またパターン形状、耐熱性などに劣ることがあり、一方 10×10^4 を超えると、感度が低下したりパターン形状に劣ることがある。

【0027】上記のような本発明で用いられる共重合体 [A]は、不飽和カルボン酸(a-1)と、上記式 [I]で示されるエボキシ基含有ラジカル重合性化合物 (a-2)と、他のラジカル重合性化合物 (a-3)を、種々の重合方法により共重合させることによって得られるが、溶媒中で、触媒(重合開始剤)の存在下に共重合させる方法が好ましい。

【0028】共重合に用いられる溶媒の具体例として は、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノー ルなどのアルコール類: テトラヒドロフラン、ジオキサ ンなどの環状エーテル類;メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテートなどのセロソルブエス テル類: エチレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエ チルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのグ リコールエーテル類;プロピレングリコールメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテ ルアセテートなどのプロピレングリコールアルキルエー テルアセテート類;ベンゼン、トルエン、キシレンなど の芳香族炭化水素類;メチルエチルケトン、シクロヘキ サノン、2-ヘプタノン、4-ヒドロキシー4-メチル -2-ペンタノンなどのケトン類; 2-ヒドロキシプロ ピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオ ン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸 エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、 2-ヒドロキシー3-メチルブタン酸メチル、3-メト キシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸工 チル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシ プロピオン酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエ ステル類; ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピ ロリドンなどの非プロトン性極性溶媒が挙げられる。こ れらの溶媒は、重合性化合物 [(a-1)、(a-2)

および (a-3)] の合計 100重量部に対して、通常 20~1000重量部の量で用いられる。

【0029】また、触媒としては、一般的にラジカル重合開始剤として知られているものを広く用いることができ、例えば2,2'ーアゾビスイソブチロニトリル、2,2'ーアゾビス(4ージメチルバレロニトリル)、2,2'ーアゾビス(4ーメトキシー2,4ージメチルバレロニトリル)などのアゾ化合物;ベンゾイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド、セーブチルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド、セーブチルパーオキシド、ラウロインなどの有機過酸化物および過酸化水素などを用いることができる。ラジカル重合開始剤として過酸化物を聞元剤とともに用いてレドックス型重合開始剤としてもよい。さらに、上記共重合において、αーメチルスチレンダイマーなどの分子量調節剤を添加することもできる。

【0030】上記共重合体 [A] は、カルボキシル基と エボキシ基とを有しており、アルカリ可溶性と自己架橋 性とを有する。また、共重合体 [A] は、アルカリ水溶 液に対して適切な溶解性を有しており、高感度、高残膜 率且つ現像性に優れた感放射線性樹脂組成物を得ること ができる。さらに共重合体 [A] を用いることによって 得られるレジストパターンは、耐熱性、基板との密着 性、可視光域での透明性、耐薬品性などの諸特性に優れ る。

【0031】[B] 1,2-キノンジアジド化合物 本発明で用いられる1,2-キノンジアジド化合物としては、ヒドロキシ化合物と1,2-キノンジアジドスルホン酸とのエステル化物が用いられる。この1,2-キノンジアジド化合物としては、ヒドロキシ化合物の水酸基の全てまたは一部が1,2-キノンジアジドスルホン酸でエステル化された化合物を用いることができ、具体的にヒドロキシ化合物の水酸基の20~100%が1,2-キノンジアジドスルホン酸でエステル化された化合物を用いることができる。

【0032】このような1,2-キノンジアジド化合物の具体例としては、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどの、トリヒドロキシベンゾフェノンと1,2-キノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;2,2',4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,2',4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,

3'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフ トキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2,3, 4,3'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンー1,2-ナ フトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3, フトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3, 4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナ フトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,3, 4,2'ーテトラヒドロキシー4'ーメチルベンゾフェ ノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸 エステル、2,3,4,2'ーテトラヒドロキシー4'ー メチルベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド -5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'-テトラヒ ドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノン-1,2-ナ フトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2.3. 4,4'ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフ ェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン 酸エステルなどの、テトラヒドロキシベンゾフェノンと 1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル 化物:

【0033】2,3,4,2',6'ーペンタヒドロキシベ ンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ース ルホン酸エステル、2,3,4,2',6'-ペンタヒドロ キシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、3,4,5,2',4'-ペンタ ヒドロキシベンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジア ジド-4-スルホン酸エステル、3,4,5,2',4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ペンタヒ ドロキシベンゾフェノンと1,2-ナフトキノンジアジ ドスルホン酸とのエステル化物; 2,4,6,3',4', 5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフ トキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、2,4, 6,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン -1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テル、3,4,5,3',4'5'-ヘキサヒドロキシベン ゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、3,4,5,3',4',5'-ヘキサヒ ドロキシベンゾフェノン-1.2-ナフトキノンジアジ ドー5ースルホン酸エステルなどの、ヘキサヒドロキシ ベンゾフェノンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホ ン酸とのエステル化物;

【0034】ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどの、ビスジヒドロキシフェニルメタンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;ビス(p-ヒドロキシフェニル)メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、ビス

(pーヒドロキシフェニル) メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ピスヒドロキシフェニルメタンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物; トリ(pーヒドロキシフェニル) メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、トリ(pーヒドロキシフェニル) メタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、トリヒドロキシフェニルメタンと1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物;

【0035】1.1.1ートリ(pーヒドロキシフェニ ル) エタンー1,2-ナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、1,1,1-トリ(p-ヒドロキシフェ ニル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステルなどの、トリヒドロキシフェニルエタ ンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエス テル化物; ビス (2,3,4-トリヒドロキシフェニル) メタンー1.2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン 酸エステル、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニ ル) メタン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スル ホン酸エステルなどの、ビストリヒドロキシフェニルメ タンと 1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸とのエ ステル化物; 2,2-ビス(2,3,4-トリヒドロキシ フェニル) プロパンー1,2-ナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、2,2-ビス(2,3,4-ト リヒドロキシフェニル) プロパンー1,2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビストリ ヒドロキシフェニルプロパンと1,2-ナフトキノンジ アジドスルホン酸とのエステル化物;1,1,3-トリス (2,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)-3-フェニルプロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-4 ースルホン酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジ メチルー4ーヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロ パン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 エステルなどの、トリス(ジメチルヒドロキシフェニ ル) フェニルプロパンと1,2-ナフトキノンジアジド スルホン酸とのエステル化物;

ニル) -2-ヒドロキシフェニルメタン-1,2-ナフ トキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの、ビ ス(ジメチルヒドロキシフェニル)ヒドロキシフェニル メタンと1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸との エステル化物; 3,3,3',3'ーテトラメチルー1, 1'-スピロインデン-5,6,7,5',6',7'-へ キサノールー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、3,3,3',3'ーテトラメチルー1, 1'-スピロインデン-5,6,7,5',6',7'-へ キサノールー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースル ホン酸エステルなどの、テトラメチルスピロインデンへ キサノールと 1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸 とのエステル化物;2,2,4ートリメチルー7,2'. 4'-トリヒドロキシフラバン-1,2-ナフトキノン ジアジドー4ースルホン酸エステル、2,2,4ートリメ チルー7,2',4'ートリヒドロキシフラバンー1,2 ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステルなど の、トリメチルトリヒドロキシフラバンと1,2ーナフ トキノンジアジドスルホン酸とのエステル化物が挙げら hs.

【0037】これらのうち、2,3,4ートリヒドロキシ ベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ー スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒドロキシベンゾ フェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベ ンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステル、3,4,5,2',4'ーペンタヒドロ キシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) -3-フェニルプ ロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチル-4 ーヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、 4.4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニ ル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ピス フェノールー1,2-ナフトキノンジアジドー4-スル ホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジ アジドー5ースルホン酸エステル、2,2,4ートリメチ ルー7,2',4'ートリヒドロキシフラバンー1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2. 2,4-トリメチルー7,2',4'-トリヒドロキシフ ラバン-1,2- ナフトキノンジアジドー5-スルホ ン酸エステル、1,1,1-トリ(p-ヒドロキシフェニ ル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、1,1,1-トリ(p-ヒドロキシフェ

ニル) エタン-1.2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどが好ましく用いられる。これらの1,2-キノンジアジド化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0038】上記のような1.2ーキノンジアジドスルホン酸エステル類は、例えば1,2ーキノンジアジドスルホン酸のハロゲン化物を、塩基触媒の存在下で、対応するヒドロキシ化合物でエステル化させることにより得られる。

【0039】このようなエステル化反応においては、ヒドロキシ化合物の全水酸基に対して、1,2-キノンジアジドスルホン酸のハロゲン化物を通常10~120モル%用いることが望ましい。

【0040】[C]潜在性酸発生剂

本発明で用いられる潜在性酸発生剤は、加熱により酸を 発生するカチオン重合触媒であり、スルホニウム塩、ベ ンゾチアゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩 などのオニウム塩が用いられる。中でも、スルホニウム 塩およびベンゾチアゾリウム塩が好ましい。

【0041】上記スルホニウム塩の具体例としては、4 ーアセトフェニルジメチルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、4ーアセトキシフェニルジメチルス ルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ジメチルー 4-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)フェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルー 4-(ベンゾイルオキシ)フェニルスルホニウム ヘキ サフルオロアンチモネート、ジメチルー4-(ベンゾイ ルオキシ) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアル セネート、ジメチルー3-クロロー4-アセトキシフェ ニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネートなど のアルキルスルホニウム塩;ベンジル-4-ヒドロキシ フェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、ベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスル ホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4ーアセトキ シフェニルベンジルメチルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ベンジルー4-メトキシフェニルメ チルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ベ ンジルー2ーメチルー4ーヒドロキシフェニルメチルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ベンジル ー3ークロロー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウム ヘキサフルオロアルセネート、4ーメトキシベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム キサフルオロホスフェートなどのベンジルスルホニウム 塩:

【0042】ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジル -4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、4-アセトキシフェニルジベンジルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジ ルー4-メトキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ジベンジルー3-クロロー4-ヒド ロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネ ート、ジペンジルー3ーメチルー4ーヒドロキシー5ー tert-ブチルフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシベンジルー 4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ ホスフェートなどのジベンジルスルホニウム塩;p-ク ロロベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、p-ニトロベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム へ キサフルオロアンチモネート、p-クロロベンジルー4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロホスフェート、pーニトロベンジルー3ーメチルー 4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、3,5-ジクロロベンジルー4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロアンチモネート、o-クロロベンジル-3-クロロ -4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサ フルオロアンチモネートなどの置換ベンジルスルホニウ ム塩:下記式(1)~(7)で示されるスルホニウム塩 が挙げられる。

[0043]

【化3】

【0044】上記ベンゾチアゾニウム塩の具体例としては3-ベンジルベンゾチアゾリウムヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロホスフェート、3-ベンジルベンゾチアゾリウム テトラフルオロボレート、3-(p-メトキシベンジル)ベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルー2-メチルチオベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルー5-クロロベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネートなどのベンジルベンゾチアゾリウム塩が挙げられる。

【0045】これらのうち、4ーアセトキシフェニルジメチルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4ーアセトキシフェニルベンジルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4ーアセトキシフェニルベンジルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、3ーベンジルベンゾチアゾリウムヘキサフルオロアンチモネートなどが好ましく用いられる。これ

らの市販品としては、サンエイド SI-L85、同SI-L110、同SI-L145、同SI-L150、同SI-L150、同SI-L160(三新化学工業(株)製)などが挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0046】他の成分

本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、感度をさらに向上させる目的で、1,2-キノンジアジド化合物に対する増感剤を含んでいてもよい。このような増感剤としては、2H-ピリドー(3,2-b)-1,4-オン類、10H-ピリドー(3,2-b)-1,4-ベンゾチアジン類、ウラゾール類、ヒダントイン類、バルビツール酸類、グリシン無水物類、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール類、アロキサン類、マレイミド類などが挙げられる。上記増感剤は、1,2-キノンジアジド化合物[B]100重量部に対して、通常100重量部以下、好ましくは10重量部以下の量で必要に応じて用いられる。

【0047】また、本発明の窓放射性樹脂組成物は、耐熱性、基板との密着性を向上させる目的で、分子内に少なくとも2個のエポキシ基を有するラジカル重合性を有

さない化合物を含んでいてもよい。このような化合物と しては、例えばエピコート1001、同1002、同1 003、同1004、同1007、同1009、同10 10、同828 (商品名;油化シェルエポキシ(株) 製) などのビスフェノールA型エポキシ樹脂;エピコー ト807 (商品名:油化シェルエポキシ (株)製)など のビスフェノールF型エポキシ樹脂;エピコート15 2、同154(商品名:油化シェルエポキシ(株) 製)、EPPN201、同202(商品名;日本化薬 (株) 製) などのフェノールノボラック型エボキシ樹 脂; EOCN102、同103S、同104S、102 0、1025、1027(商品名:日本化薬(株) 製)、エピコート180S75(商品名;油化シェルエ ポキシ(株)製)などのクレゾールノボラック型エポキ シ樹脂; エピコート1032H60、同XY-4000 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのポリフ ェノール型エポキシ樹脂、CY-175、同177、同 179、アルダライトCY-182、同192、184 (商品名: チパーガイギー (株) 製)、ERL-423 4、4299、4221、4206(商品名; U.C.C 社製)、ショーダイン509(商品名;昭和電工(株) 製)、エピクロン200、同400(商品名;大日本イ ンキ(株)製)、エピコート871、同872(商品 名;油化シェルエポキシ(株)製)、ED-5661、 同5662(商品名;セラニーズコーティング(株) 製)などの環状脂肪族エポキシ樹脂;エポライト100 MF(共栄社油脂化学工業(株)製)、エピオールTM P (日本油脂(株)製)などの脂肪族ポリグリシジルエ ーテルなどが挙げられる。

【0048】これらの化合物は、共重合体 [A] 100 重量部に対して、50重量部以下の量で必要に応じて用いられる。

【0049】さらに本発明の感放射性樹脂組成物は、ス トリエーション (塗布すじあと) の防止、現像性の向上 などの目的で、界面活性剤を配合することもできる. 界 面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリル エーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポ リオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオキシエ チレンアルキルエーテル類; ポリオキシエチレンオクチ ルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニ ルエーテルなどのポリオキシエチレンアリールエーテル 類:ポリオキシエチレンジラウレート、ポリオキシエチ レンジステアレートなどのポリオキシエチレンジアルキ ルエステル類などのノニオン系界面活性剤;エフトップ EF301、同303、同352(新秋田化成(株) 製)、メガファックF171、同F172、同F173 (大日本インキ化学工業(株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、 アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同S C-101、同SC-102、同SC-103、同SC

-104、同SC-105、同SC-106 (旭硝子 (株) 製)などのフッ素系界面活性剤;オルガノシロキサンポリマーKP341 (信越化学工業(株)製)、ポリフローNo.57、同95 (共栄社油脂化学工業(株)製)などの(メタ)アクリル酸共重合体系界面活性剤が挙げられる。上記界面活性剤は、感放射線性樹脂組成物の固形分100重量部に対して、2重量部以下、好ましくは1重量部以下の量で必要に応じて用いられ

【0050】その他、本発明の感放射線性樹脂組成物は、基板との密着性を向上させる目的で、密着助剤を含んでいてもよい。このような密着助剤としては、官能性シランカップリング剤などが挙げられる。さらに本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、必要に応じて帯電防止剤、保存安定剤、消泡剤、顔料、染料などを含んでいてもよい。

【0051】感放射線性樹脂組成物

本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の共重合体 [A]、1,2-キノンジアジド化合物、潜在性酸発生 剤および必要に応じて他の成分からなるが、共重合体 [A]100重量部に対して、1,2-キノンジアジド 化合物 [B]を5~100重量部、好ましくは10~50重量部、潜在性酸発生剤 [C]を0.1~50重量 部、好ましくは1~10重量部含んでいることが望ましい。

【0052】感放射線性樹脂組成物中の1,2-キノンジアジド化合物の量が、共重合体 [A] 100重量部に対して5重量部未満であると、該組成物から形成される塗膜は放射線照射部と放射線未照射部との溶解度差が小さくなって現像によるパターニングが困難になることがあり、一方100重量部を超えると、短時間の放射線照射では1,2-キノンジアジド化合物が充分に分解されず、感度が低下してしまうことがある。また、潜在性酸発生剤の量が、共重合体 [A] 100重量部に対して0.1重量部未満であると、加熱時に発生する酸の量が少ないため、系の架橋密度が十分に上がらず、耐薬品性が低下する場合がある。一方50重量部を超えると、保存中に潜在性酸発生剤が樹脂組成物溶液中に析出してくる場合がある。

【0053】本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の各成分を均一に混合することによって容易に調製することができ、通常、適当な溶媒に溶解されて溶液状態で用いられる。例えば、共重合体 [A]を溶媒に溶解し、この溶液に1,2-キノンジアジド化合物、潜在性酸発生剤および必要に応じて他の成分を所定の割合で混合することにより、溶液状態の感放射線性樹脂組成物を調製することができる。

【0054】該溶媒としては、共重合体 [A]を製造する際に用いられた溶媒と同様の溶媒を用いることができる。さらに、Nーメチルホルムアミド、N,Nージメチ

ルホルムアミド、N-メチルホルムアニリド、N-メチルアセトアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ペンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセテートなどの溶媒を用いることもできる。

【0055】これらの溶剤のうち、溶解性および塗膜の 形成のしやすさから、エチレングリコールモノエチルエ ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルなど のグリコールエーテル類;エチルセロソルブアセテート などのエチレングリコールアルキルエーテルアセテート 類:乳酸エチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチルな どのエステル類;ジエチレングリコールモノメチルエー テルなどのジエチレングリコール類;2-ヘプタノンな どのケトン類が好ましく用いられる。

【0056】本発明の感放射線性樹脂組成物は、固形分 濃度が好ましくは20~40重量%となるように溶媒に 溶解された溶液として被塗布物に塗布される。また、上 記のように調製された感放射線性樹脂組成物溶液は、孔 径が0.2μm程度のフィルタなどを用いて沪過した 後、使用に供することが好ましい。このように調製された感放射線性樹脂組成物溶液は、長期間の貯蔵安定性に も優れる。

【0057】使用法

上記感放射性樹脂組成物溶液は、基板表面に塗布し、加熱により溶媒を除去することによって、塗膜を形成することができる。基板表面への感放射性樹脂組成物溶液の塗布方法は、例えばスプレー法、ロールコート法、回転塗布法などの各種の方法を採用することができる。

【0058】次いでこの塗膜は、加熱(プレベーク)される。加熱することによって、溶剤が揮発し、流動性のない塗膜が得られる。加熱条件は、各成分の種類、配合割合などによっても異なるが、通常60~120℃で10~600秒間程度である。

【0059】次に加熱された塗膜に所定パターンのマスクを介して放射線を照射した後、現像液により現像し、不要な部分を除去する。現像液としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水などの無機アルカリ類;エチルアミン、n-プロピルアミンなどの第一級アミン類;ジエチルアミン、ジーnープロピルアミンなどの第二級アミン類;トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、N-メチルピロリドンなどの第三級アミン類;ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミンなどのアルコールアミン類;テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、アトラエチルアンモニウムヒドロキシア

ロキシド、コリンなどの第四級アンモニウム塩; ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] -5-ノナンなどの環状アミン類のアルカリ類からなるアルカリ水溶液を用いることができる。また上記アルカリ水溶液に、メタノール、エタノールなどの水溶性有機溶媒、界面活性剤などを適当量添加した水溶液を現

像液として使用することもできる。

【0060】現像時間は、通常30~180秒間であり、また現像の方法は液盛り法、ディッピング法などのいずれでも良い。現像後、流水洗浄を30~90秒間行い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基板上の水分を除去し、パターン状被膜が形成される。その後このパターン状被膜に、高圧水銀灯などによる放射線を全面照射し、パターン状被膜中に残存する1.2~キノンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホットプレート、オーブンなどの加熱装置により、所定温度、例えば150~250℃で、所定時間、例えばホットプレート上なら5~30分間、オーブン中では30~90分間加熱処理をすることによって、パターン状架橋被膜を得ることができる。

[0061]

【実施例】次に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 【0062】共重合体[A]の合成_

合成例1 (共重合体 [A-1]の合成)

搬拌機、冷却管、窒素導入管および温度計を装着したセパラブルフラスコに、表1に示す各化合物を仕込み、30分間窒素でパージした後、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を70℃に保って3時間重合反応を行った。得られた重合体溶液の固形分濃度は、27.9重量%であった。共重合体 [A-1]のMwは、1.12×10℃であった。なおMwは、GPC(ゲルパーミエイションクロマトグラフィ)(東ソー(株)製HLC-8020)を用いて測定したポリスチレン換算分子量である。(以下、同じ。)

【0063】合成例2~5 (共重合体 [A-2]~[A-3]の合成)

合成例1において、表1に示すような各成分および溶媒を表1に示す量で仕込んだ以外は、合成例1と同様にして共重合体[A-2]~[A-5]を含む重合体溶液を得た。得られた各重合体溶液の固形分濃度およびMwを表1に併せて示す。

[0064]

【表1】

| | | # | 共聞合存 | 14 | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|----------|
| (8) | [V-V] | [A-1] [A-2] [A-3] [A-4] [A-5] | [8-Y] | [A-4] | [A-5] |
| (8-1) メタクリル数 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | | |
| イタコン版モノメチルイタコン版モノゾチル | | | | 20 | е. 14 |
| (a-2) p-ピニンベンジルグリシジルエーテル | 27.0 | 33.0 | 87.0 | 30 | 3 8 |
| ルジシリングルリックをよ (8−8) | 62.0 | 33.0 | | 30 | 20 |
| メタクリル概ジシクロベンタニルスチンン | | 0.0 | | 00 | 0 |
| 重合器約 N.N アゾピス-2,4-ジメチルベレロニトリル | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
| 谷 城 ジエチレングじコールジメチルエーテル | | | | 200 | 200 |
| | 250 | 200 | |) |) |
| 2ーヒドロキシブロピオン酸エチル | | | 100 | | |
| 重合体術液の団形分線度 (重量%) | 27.9 | 32.4 | 48.3 | 80.2 | 31.5 |
| Mw (×10⁴) | 1.12 | 0.98 | i.35 | 1.48 | 1.86 |
| | | | | | |

【0065】感放射線性樹脂組成物の評価

以下の実施例で得られる感放射線性樹脂組成物について、下記のようにパターン状被膜を形成して評価した。 (i) 4インチのシリコンウェハに、各実施例で得られた感放射線性樹脂組成物(表3に示す)の溶液をスピンナーを用いて塗布した後、90℃で2分間ホットプレート上で加熱して膜厚2.0μmの塗膜を形成した。

(ii)得られた塗膜を、(株)ニコン製NSR-1755i7A縮小投影露光機(NA=0.50、入=365nm)により露光時間を変化させて露光した後、表3に示す濃度のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて、25℃で1分間現像した。

(i i i) 次いで、塗膜を水でリンスし、乾燥することによりシリコンウェハ上にパターン状被膜を形成した。 【0066】評価項目と評価方法を以下に示す。

[感度]上記のように作成されたパターン状被膜において、ライン線幅2.0μmのパターン状被膜が得られるのに必要な露光時間(以下、「最適露光時間」という。)を求めた。

[解像度] 最適露光時間において解像している最小のスペースパターンの寸法を走査型電子顕微鏡で測定した。 [残膜率] (現像後の膜厚/現像前の膜厚) ×100を求め、90%以上を○とし、90%未満を×とした。 [現像性] 現像後のパターン状被膜の表面荒れ、スペース部分の現像残り(スカム)の有無を走査型電子顕微鏡で観察した。スカムが認められなかったときを○とし、認められたときを×とした。

【0067】[パターン形状] 最適露光時間におけるパターン状被膜の断面形状を走査型電子頭微鏡で観察した。断面形状の評価基準を表2に示す。形状がAのように正方形あるいは長方形の場合は良好(〇)とし、BあるいはCのようにAの形状とは異なることが認められたときは不良(×)とした。

【0068】 【表2】

A B C Minipite C

【0069】 [耐熱性] 約100 μ m×100 μ mのパターン状被膜が形成されたシリコンウェハに、365nmにおける光強度が5mwの紫外線を60秒間照射した。その後ホットプレートで200℃で15分間加熱した。加熱後のパターン状被膜をさらに1時間加熱し、熱分解による膜減りが3%以上となる温度を調べた。この温度が230℃以上を〇とし、200℃以上230℃未満を Δ とし、200℃未満を×とした。

【0070】[密着性] 0.66μmの熱酸化膜付きシリコンウェハを用いて、5.0μmL/Sパターン状被膜を形成し、150℃で5分間ホットプレートで加熱した。加熱されたシリコンウェハを、40重量%フッ化アンモニウム水溶液と50重量%フッ化水素水溶液との6:1(容量比)混合液である25℃エッチング液に6分間浸漬し、パターン状被膜のアンダーカット(表2で示されるパターン形状の最上部と最下部のパターン幅の

差) を走査型電子顕微鏡で観察し、1.0μm未満をOとし、1.0μm以上1.3μm未満をΔとし、1.3μm以上を×とした。

【0071】[耐薬品性] 耐熱性の評価と同様にして、約100μm×100μmのパターン状架橋被膜を形成し、ジメチルスルホキシドに80℃で15分間浸漬し、浸漬前後の膜厚の変化率と、被膜の表面状態を調べた。表面に荒れが認められず、且つ膜厚の変化率が5%未満のものを○とし、表面に荒れが認められず、且つ膜厚の変化率が5%以上10%未満のものを△とし、表面に荒れが認められるもの、または膜厚の変化率が10%以上のものを×とした。

【0072】感放射線性樹脂組成物の調製

実施例1

合成例1で得られた共重合体 [A-1] (固形分)10 0重量部と、1,2ーキノンジアジド化合物として、3. 4,5,2',4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン (1モル)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スル ホン酸クロリド (4モル) との縮合物 ([B-1]) 4 〇重量部と、潜在性酸発生剤として、サンエイドSI-L150 (三新化学工業(株)製)3.5重量部とを混 合し、固形分濃度が30重量%になるようにジエチレン グリコールジメチルエーテルに溶解させた後、孔径0. 45 µ mのミリポアフィルタで沪過して感放射線性樹脂 組成物溶液を調製した。得られた感放射線性樹脂組成物 溶液から、上記(i)のようにしてパターンを形成し、 評価した。結果を表3および表4に示す。またこの窓放 射線性樹脂組成物溶液を5℃で3か月間保存した後、パ ターン状被膜を形成して評価した結果、上記のような調 製直後の感放射線性樹脂組成物と同等の結果が得られ、

この感放射線性樹脂組成物は貯蔵安定性にも優れている ことがわかった。

【0073】実施例2~15

実施例1において、表1に示すような各成分に代えた以 外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液 を調製した。結果を表3および表4に示す。

【0074】なお、表3中、成分の略称は次の化合物を示す。

[B-3]・・・1,1,3-トリス(2,5-ジメチル -4-ヒドロキシフェニルー3-フェニル)プロパン (1モル)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スル ホン酸クロリド(1.9モル)との縮合物

[B-4]・・・2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェ ノン(1モル)と1,2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸クロリド(2.6モル)との縮合物

【0075】比較例

実施例1において、潜在性酸発生剤成分を用いなかった 以外は、実施例1と同様にパターン状被膜を形成した。 結果を表3および表4に示す。

[0076]

【表3】

| | 共重合体 | 1.2-+ | ノンジアジド | 潜在性酸発生剤 | | 現像被過度 | 庭 度 | 解像度 |
|-------------|-------------|-------------|--------|---------|-------|---------------|----------|------|
| | の種類 | 種類 | 重量部か | 種類 | 重量部17 | (Xiw ps HAMT) | (mj/cm²) | (µm) |
| 実施例1 | A-1 | B-1 | 40 | C-1 | 3.5 | 0.1 | 120 | 0.7 |
| " 2 | " | $B-\bar{2}$ | 30 | N | " | " | 150 | 0.6 |
| " 3 | 17 | B-3 | | " | " | " | 190 | 0.6 |
| <i>"</i> 4 | # | B-4 | 27 | " | N I | " | 100 | 0.8 |
| " 5 | n | B-1 | 40 | | " | * | 120 | 0.7 |
| <i>"</i> 6 | A-2 | B-1 | V | # | 1.0 | 0.5 | 150 | 0.7 |
| 7 7 | # | B-2 | 30 | // | W | | 180 | 0.6 |
| " 8 | " | B-3 | | ** | W | # | 220 | 0.6 |
| <i>"</i> 9 | " | B-4 | W | R | " | # | 110 | 0.8 |
| " 10 | 17 | B-2 | JJ | " | " | 11 | 180 | 0.6 |
| " 11 | A-3 | B-2 | " | " | 2.0 | 0.2 | 160 | 0.6 |
| <i>σ</i> 12 | | B-3 | 11 | # | " | H | 190 | 0.6 |
| 7 13 | A-4 | B-2 | " | " | " | # | 170 | 0.6 |
| // 14 | " | B-3 | H | " | " | H | 200 | 0.6 |
| 7 15 | A-5 | B-2 | " | B | " | 0.3 | 130 | 0.6 |
| 7 18 | # | B-3 | " | " | 77 | <i>H</i> | 180 | 0.6 |
| 比較例 | A - 1 | B-1 | 10 | | _ | 0.1 | 120 | 0.7 |

注: 1)重量部は、共重合体100重量部に対する値である。

[0077]

| | | 現像性 | 残膜率 | パターン形状 | 耐熱性 | 密着性 | 耐薬品性 |
|----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 実施的 | Ŋ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0_ |
| 11 | - 8 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| " | 9 | O | 0 | 0 | 0 | O. | 0 |
| ~ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0_ | 0 | 0 |
| " | 11 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| " | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .,, | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 列 | 0 | 0 | 0 | Δ | 0 | × |

[0078]

【発明の効果】本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、 感度、現像性、残膜率、耐熱性、基板との密着性、透明 性に優れるとともに、とりわけ耐薬品性に優れた被膜 (パターン)を形成することができる。このような本発 明の感放射線性樹脂組成物は、半導体集積回路(IC) および液晶ディスプレイ(LCD)用薄膜トランジスタ (TFT)回路のみならず、回路製造用のマスクなどを 作成するためなどのボジ型レジストとして、さらには層 間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜などの永久膜用形成 材料としても好適である。

【0079】以上、詳述した本発明の感放射線性樹脂組成物について、好ましい態様を下記する。

- 1. 共重合体 [A] が (a-1) 成分を5~50重量 %、(a-2) 成分を5~90重量%、そして、(a-3) 成分を5~70重量%含有する組成物。
- 2. 共重合体 [A]の (a-1) 成分がメタクリル酸、 アクリル酸およびイタコン酸から選択される少なくとも 1種であり、(a-2) 成分が o ービニルベニジルグリ

シジルエーテル、m-ビニルベンジルグリシジルエーテルおよびp-ビニルベンジルグリシジルエーテルから選択される少なくとも1種であり、そして(a-3)成分がメタクリル酸グリシジルおよびスチレンの少なくともいずれかである組成物。

- 3. 共重合体 (A) のポリスチレン換算重量平均分子量 が2×10³~1×10⁵である組成物。
- 4.1,2-キノンジアジド化合物が、ヒドロキシ化合物と1,2-キノンジアジドスルホン酸とのエステル化物である組成物。
- 5. 潜在性酸発生剤が、加熱により酸を発生するオニウム塩である組成物。
- 6. オニウム塩が、スルホニウム塩およびベンゾチアゾリウム塩の少なくともいずれかである上記5の組成物。7. 共重合体 [A] 100重量部に対して、1,2-キノンジアジド化合物を5~100重量部、より好ましくは10~50重量部、潜在性酸発生剤を0.1~50重量部、より好ましくは1~10重量部含有している組成物。

フロントページの続き

| (51) Int. Cl. 6 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | | | 技術表示箇所 |
|-----------------|--------|------|--------|------|-------|------|--------|
| G03F | 7/027 | 515 | | G03F | 7/027 | 515 | |
| | 7/029 | | | | 7/029 | | |
| | 7/033 | | | | 7/033 | | |
| H01L | 21/027 | | | H01L | 21/30 | 502R | |